# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-154648

(43)Date of publication of application: 09.06.1998

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 7/20 G06F 17/50

(21)Application number: 08-312269

(71)Applican

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

22.11.1996

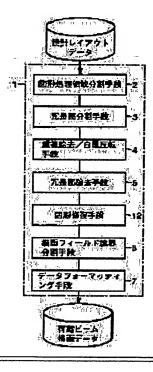
(72)Inventor:

KAMIYAMA KINYA MORIIZUMI KOICHI TAOKA HIRONOBU

# (54) CHARGED BEAM LITHOGRAPH DATA GENERATING DEVICE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a charged beam lithography generating device which can efficiently prevent degradation of size accuracy of a drawing pattern.

SOLUTION: A charged beam lithography data generating device 1 is provided with a reducing part dividing means 3 for dividing a redundant part formed by joining redundant areas of computer graphics areas and an inner area defined in the computer graphics area by the outline of the redundant part. A design layout data is divided by the redundant part dividing means 4 between the redundant part and the inner area. An overlap removal is separately performed in reach of the areas.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平10-154648

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

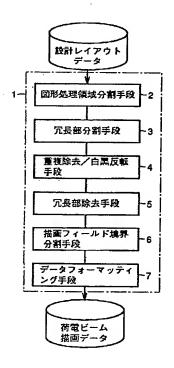
(51) Int.Cl. <sup>8</sup>	- Enchange		
	酸別記号	FI	
H01L 21/027		H 0 1 L 21/30	541J
G03F 7/20	504	G03F 7/20	5 0 <del>4</del>
G06F 17/50		G06F 15/60	658M
		H01L 21/30	541C
			5 4 1 Z
		審査請求 未請求	請求項の数5 OL (全 16 頁)
(21)出願番号	特顯平8-312269	(71)出額人 000006013	
•		三菱電板	幾株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)11月22日	東京都=	千代田区丸の内二丁目2番3号
		(72)発明者 上山 欣也	
			・・- f代田区丸の内二丁目2番3号 三
			株式会社内
		(72)発明者 森泉	
			・ F代田区丸の内二丁目2番3号 三
			株式会社内
		(72)発明者 田岡 引	
•			
			F代田区丸の内二丁目2番3号 三
			株式会社内
		(74)代埋人 弁埋士	深見 久郎 (外3名)

### (54) 【発明の名称】 荷電ビーム描画データ作成装置

### (57)【要約】

【課題】 描画バターンの寸法精度劣化を効果的に抑制 可能な荷電ビーム描画データ作成装置を提供する。

【解決手段】 荷電ビーム描画データ作成装置1は、各図形処理領域の冗長領域を連結して形成された冗長部と、この冗長部の外周によって図形処理領域内に規定される内部領域とに分割する冗長部分割手段3を備える。この冗長部分割手段3によって上記の冗長部と内部領域とに設計レイアウトデータを分割し、各々の領域内で独立して重複除去処理を行なう。



る描画データ作成上の問題点について説明する。図20 に示されるパターンデータ20が描画データに変換され、との描画データを用いてマスク上に描画され、さらにレジストの現像によって形成されたマスク上のレジストパターンを図23に示す。とのレジストパターン21 の幅Wmの部分のパターン寸法精度に着目し、その精度劣化要因について考える。ただし、とこでは、レジスト現像等のパターン形成プロセス条件等に関する要因は考慮しない。

【0009】図20に示されるバターンデータ20が図 1021のように水平方向の分割線で分割されている場合、幅Wmの寸法に影響を与えるのは、図21の領域20aの図形に合わせて成形された電子ビームの成形精度、すなわち、幅Ws1に相当する部分の電子ビームの寸法精度のみである。

【0010】しかし、図22のように垂直方向の分割線で分割されている場合、幅Wmの寸法に影響を与えるのは、図22の領域20cに対応する電子ビームの照射位置精度、領域20dに対応する電子ビームの照射位置精度、ならびに成形精度となる。そのため、図21に示さ 20れるように水平方向の分割線によって分割された場合と比較して、レジストバターン寸法精度に影響する要因が2点も多くなる。

【0011】実際に、図21および図22に示すような分割方法の異なる描画データを用いて複数のレジストパターンを形成し、寸法測定した結果を図24と図25に示す。図24は、図21に示す描画データを用いた場合であり、1ショットの電子ビーム照射で幅Wmの部分のレジストパターンが形成された場合である。図25は、図22に示す描画データを用いた場合であり、幅Wmの 30部分のレジストパターンが照射位置の異なる2ショットの電子ビーム照射で形成された場合の結果である。

【0012】図24および図25に示されるように、1ショットの電子ビーム照射によりレジストパターンが形成された場合に寸法のばらつきが±0.025μm程度であるのに対し、2ショットの電子ビーム照射でパターンが形成された場合の寸法のばらつきは±0.075μm程度となっている。つまり、2ショットの電子ビーム照射により、パターン寸法のばらつき、すなわち寸法精度が劣化することがわかる。これが、可変成形型の描画 40データ作成上の問題点の1つである。

【0013】また、ショット位置の異なる2ショット以上の電子ビーム照射でレジストバターンが形成され、その複数のショットの中でレジストパターンのエッジを形成するショットが微小なサイズである場合には、形成されるレジスト寸法の精度が、さらに劣化する。これについて、図26および図27を用いて説明する。

【0014】図26(b) に示したグラフは、図26(a) のように成形された電子ビームの強度分布を示している。電子ビームの強度分布は完全な矩形ではなく、

エッジ部分で広がった状態になる。とのエッジでの強度 分布のスロープ(以下「ビームシャープネス」と称す る)が、成形ビームのサイズによって変化する。一般的 には、成形ビームのサイズが大きいほど電子ビーム内で のクーロン反発が大きくなり、とれが原因してビームシャープネスは小さくなりエッジでの強度分布は鈍った状態になる。

【0015】図26に示す電子ビームと同じサイズのバターンを2ショットの電子ビームで照射する場合で、かつ左側のショットが微小なサイズである場合の電子ビーム(図27(a)の強度分布を図27(b)に示す。図27(a)および(b)に示されるように、1ショットで描画する場合(図26)とエッジ(左側)での強度分布が異なり、この結果、形成されるレジストバターンの寸法に差が生じる。

【0016】図27(a) および(b) に示されるように、微小図形を含む2ショットでレジストバターンを複数作成し、レジスト寸法を測定した結果を図28に示す。1ショットで描画した場合の結果(図24)と比較して、寸法のばらつきが大きくなることに加え、平均値にも差が生じる。この平均値の差が、上記の微小図形の電子ビーム照射に起因するものである。

【0017】とのような寸法精度の劣化が顕著になる微小図形のサイズは、使用する電子ビーム描画装置、レジストの種類、パターン形成プロセス方法および条件に大きく依存するが、一般的にはその図形データの幅または高さ方向のいずれかの辺の長さが0.5 μ m 以下である。

【0018】次に、従来の可変成形型電子ビーム描画装置の描画データ処理フローについて説明する。図29は、従来の荷電ビーム描画データ作成装置1の概略構成を示すブロック図である。

【0019】図29を参照して、まず荷電ビーム描画デ ータ作成装置1に入力される設計レイアウトデータが、 図形処理領域分割手段2によって、任意の大きさの図形 処理領域単位に分割される。これは、膨大な図形データ を含むLSIのチップ領域を図形処理領域に分割すると とで、一度に処理する図形データ数を削減して処理高速 化を図るとともに、描画データ作成装置のシステム構成 (特にメモリ領域)による処理容量の制限内で処理する ために行なわれる。図形処理領域分割処理の際には、冗 長領域を設け、図形処理領域の境界上にまたがる図形を 境界上で切断しないようにする。すなわち、との時点で は、冗長領域を含めた領域が図形処理領域となる。とれ は、図形処理領域境界で微小図形が発生しないように図 形データを分割するために必要な処理である。冗長領域 境界と図形処理領域境界の間隔は、意図する微小図形の サイズよりも十分大きな値であればよい。

【0020】次に、描画データ作成装置の重複除去/白50 黒反転手段4により、図形間の重複を除去する。これ

8内部に存在する場合には、そのまま図形データを出力 する(ステップS9)。

【0031】次に、境界処理について説明する。各図形 処理領域8は冗長領域9を有しており、冗長領域9内の 図形データ群は隣り合う図形処理領域8がそれぞれ保有 する。そのため、ある手順を定めることにより、微小図 形を発生させることなく冗長領域9内の図形データの重 複除去処理を図形処理領域8℃とに独立して行なうこと ができる。

【0032】 ことで、図34~図49を用いて、上記の 10 境界処理の概要について説明する。図35は、図形領域 22が図形処理領域8の左辺上にまたがる場合の境界処 理のフローチャートである。ととで、フローチャート中 のεは入力された微小図形寸法値であり、フローチャー ト中の記号は図34に対応する。

【0033】本境界処理では、図36中の図形領域22 a, 22b, 22c, 22dの全4種類の場合に対ずる 処理を行なう。図37は、図36において境界処理を実 行した結果である。図36において、図形領域22a は、図形データを図形処理領域境界で分割した際に、分 20 を用いて具体的に説明する。 割された左側部分の図形データの幅が微小図形寸法値 ε よりも小さい場合の例である。また、図形領域22b は、図形領域22aと同様に分割された右側部分の図形 データの幅が微小図形寸法値εよりも小さい場合の例で ある。図形領域22cは、図形領域22aと同様に分割 された図形データの幅が双方とも微小図形寸法値 $\epsilon$ より も大きい場合の例である。図形領域22dは、図形領域 22aと同様に分割された図形データの幅が双方とも微 小図形寸法値εよりも小さい場合の例である。

【0034】ととで、図形処理領域境界のどの辺にも共 30 通する処理は、図形処理領域境界上で図形を分割して も、微小図形が発生しない場合(図36における図形領 域22c)である。との場合は、図形処理領域境界で図 形を分割し(図35におけるステップS1~S3)、図 37に示されるように、図形処理領域8内に残る図形デ ータ(図37における図形領域22c′)のみを出力す る(図35におけるステップS4)。また、図形処理領 域上で図形を分割した場合に、分割された図形のどちら か一方が微小図形の場合(図36における図形領域22 a, 22b)で、図形処理領域8内部の図形が微小図形 になる場合(図36における図形領域22b)は、図3 7に示されるように図形を出力しない(図35における ステップS1)。また、図形処理領域8の外部の図形が 微小図形になる場合(図36における図形領域22a) は、図形処理領域境界で分割せずに、図37に示される ようにそのまま出力する(図35におけるステップS 1, S2, S4)。最後に、図36における図形領域2 2 d のような図形処理領域8の内外で双方とも微小図形 となる場合には、この図形領域22dを分割せず出力す

と上辺で上記の図形領域22dのような図形を出力し、 左辺と下辺ではそれを出力しない。

【0035】上記のような処理を図形処理領域8の右 辺、上辺および下辺にてそれぞれ行なう。図38~図4 1は、図形処理領域8の右辺の処理を示し、図42~図 45は、図形処理領域8の上辺の処理を示し、図46~ 図49は、図形処理領域8の下辺の処理が示されてい る。とれらの処理については、上記の左辺の場合と同様 であるので、説明は省略する。

【0036】上述の境界処理では、冗長領域9内におけ る図形が隣り合う図形処理領域8で双方とも同じである という前提で行なわれていた。しかしながら、斜め線を 含む図形データが入力された場合、冗長領域9内の図形 データの輪郭は隣り合う図形処理領域8で同じに見えて も、それぞれの図形処理領域8内で異なる分割線が各々 の冗長領域9内の図形データに入り、結果として隣り合 う図形処理領域8から同じ図形として把握されなくな り、境界処理が適正に行なわれないという場合があっ た。以下に、このような場合について、図50~図55

【0037】図50(a)は、LSIの設計レイアウト データ23の一種を示している。まず、図50(b)に 示されるように図形処理領域分割手段3によって冗長領 域9を含めた形で設計レイアウトデータ23が分割され る。その後、図形処理領域8℃とに重複除去の処理が行 なわれる。図50(b)の一部を拡大したものが図50 (c) に示されている。図50(c) には、隣り合う第 1と第2の図形処理領域8a,8bと、この第1と第2 の図形処理領域8a,8bが有する第1と第2の冗長領 域9a, 9bと、パターンデータ24が示されている。 【0038】そして、図51には、第1と第2の図形処 理領域8a,8bの境界上にまたがるパターンデータ2 4のみを抽出した図が示されている。図51に示される 第1と第2の図形処理領域8a,8bを分離した状態が 図52(a), (b) に示されている。図52(a), (b) に示される段階では、パターンデータ24の基本 図形への分割が既に行なわれ、第1と第2の図形処理領 域8a,8bにパターンデータ24の第1と第2の部分 24a, 24bがそれぞれ保有されている。そして、そ れぞれの図処理領域8a,8bで、前述の境界処理フロ ーチャートに基づき境界処理が行なわれる。その結果、 図53(a), (b) に示されるように、第1と第2の 部分24a,24bが24a′,24b′となる。そし て、この図53(a)。(b)に示される状態からさら に基本図形に分割した状態が図54に示されている。と のように基本図形に分割された後の第1と第2の部分2 4a″, 24b″を、図55k示されるように、再び連 結する。その結果、パターンデータ24′が得られる。 とのパターンデータ24′には、図55に示されるよう る辺を決めておく。すなわち、図形処理領域境界の右辺 50 に、欠けが見られる。このような図形データの欠けが発

置1による特徴的な処理工程を段階的に示す図である。 【0052】まず図2に示されるように、図形処理領域 分割手段2によって、第1と第2の図形処理領域8a, 8 b と、第1と第2の冗長領域9 a、9 b とが規定され る。なお、従来例との比較のため、第1と第2の図形処 理領域8a,8b間の境界上にまたがるようにパターン データ10が形成されているものとする。

【0053】次に、図3に示されるように、冗長部分割 手段3によって、パターンデータ10を、冗長部9'内 に位置する部分10cと、第1と第2の図形処理領域8 a, 8b内にそれぞれ位置する部分10a, 10bとに 分割する。なお、冗長部9′は、第1と第2の図形処理 領域8a, 8b間の境界の両側に位置する冗長領域9 a, 9bを連結して形成される。

【0054】次に、図4に示されるように、第1と第2 の図形処理領域8 a, 8 b内に位置する内部領域内の部 分10a, 10bと、冗長部9'内に位置する部分10 cとに対してそれぞれ独立して重複除去処理を行なう。 それにより、冗長部9′内に位置する部分10cを、第 形状として認識することが可能となる。具体的には、同 形状の基本図形10c1,10c2,10c3に、冗長 部9、内に位置する部分10cを分割することが可能と なる。

【0055】次に、図5に示されるように、微小図形寸 法εをパラメータとして、冗長部除去処理を行なう。そ の結果が図6に示されている。図6に示されるように、 冗長部除去処理を施すことにより、第1の図形処理領域 8 a 側の第2の部分10 c 2が10 c 2′ に変形され、 第1の図形処理領域8 a側の第3の部分10 c 3が除去 30 される。一方、第2の図形処理領域8 bでは、第1の部 分10c1が除去され、第2の部分10c2が10c 2′ に変形される。その結果、第1の図形処理領域8 a に保有される冗長部9′内の部分10cが10c′に変 形し、第2の図形処理領域8bに保有される冗長部91 内の部分10cが10c″に変形される。そして、第1 と第2の図形処理領域8a,8bを連結することによ り、図7に示されるように、欠けのないパターンデータ 10が得られる。

【0056】以上のように、第1と第2の図形処理領域 40 8a,8b間の境界を斜めに横切るパターンデータ10 が存在する場合においても、冗長部除去処理後にパター ンデータ10に欠けが生じることを効果的に阻止でき る。それにより、設計レイアウトの状態に依存すること なく、髙品質な描画データを作成することが可能とな

【0057】(実施の形態2)次に、図9~図17を用 いて、との発明の実施の形態2について説明する。図9 は、この発明の実施の形態2における荷電ビーム描画デ ータ作成装置 1 の構成を示すブロック図である。

【0058】上記の実施の形態1では、冗長部除去処理 を適正に行なうために冗長部9′の領域を完全に分離し たが、冗長部9′と内部領域11との境界(以下、「冗 長部境界」と称する)で図形が分割されることによって 微小図形が発生する可能性がある。そとで、本実施の形 態2では、冗長部除去処理の後工程として図形処理領域 内における図形修復処理を行なうべく、図形修復手段1

12

【0059】以下、図10~図15を用いて、上記の図 形修復処理について説明する。図10~図15は、本実 施の形態2における図形修復処理の各工程を段階的に示 す図である。

2を備えることを特徴としている。

【0060】まず図10に示されるように、上記の実施 の形態1の場合と同様の方法で第1と第2の図形処理領 域8a,8bをそれぞれ形成する。この図10に示され る場合では、第1と第2の図形処理領域8a.8b間の 境界にまたがるようにパターンデータ13が形成されて

【0061】次に、上記の実施の形態1の場合と同様の 1と第2の図形処理領域8a,8bの双方から見て同じ 20 方法で、冗長部分割処理を行なう。その結果が、図11 に示されている。との場合、冗長部分割処理により、パ ターンデータ13が、パターンデータ13′と、冗長部 境界に生じる微小図形データ14a, 14bとに分割さ れている。

> 【0062】次に、図12に示されるように、上記の実 施の形態1の場合と同様の方法で冗長部除去処理を行な う。それにより、図13に示されるように、第1の図形 処理領域8 a に保有される冗長部9′内の部分13 a と、第2の図形処理領域8bに保有される冗長部9′内 の部分13bとがそれぞれ形成される。

【0063】次に、上記の図形修復手段12によって、 冗長部境界に接する図形データをすべて抽出し、との抽 出された図形データを輪郭化する。つまり、この抽出さ れた図形データの輪郭を描き、既に該図形データ内に付 与されている分割線を除去する。その後、再びとの輪郭 化された図形データを基本図形に再分割する。その結果 が図14に示されている。との図14に示されるよう に、第1と第2の図形処理領域8a,8bにそれぞれ保 有される新たなパターンデータ13a', 13b'が規 定される。それにより、冗長部境界に接する微小図形デ ータ14a, 14bの発生を効果的に抑制することが可 能となる。

【0064】上記のようにして図形修復処理を行なった 後に、図15に示されるように、第1と第2の図形処理 領域8a,8bを連結する。その結果、冗長部境界での 微小図形の発生を効果的に抑制でき、かつ上記連結後の パターンデータ13″における欠けの発生をも効果的に 抑制することが可能となる。

【0065】ととで、上述の図形修復手段12の構成の 50 一例と図形修復処理の概要とについて図16および図1

冗長部境界に接する微小図形データの発生を効果的に抑 制することが可能となる。

【0080】また、上記の図形抽出手段が微小図形デー タと該微小図形データに接する図形データのみを選択的 に抽出する機能を有する場合には、図形データを抽出し た後の処理対象を上記の場合よりも低減することが可能 となる。それにより、上記の場合よりも処理速度を向上 させることが可能となる。また、図形修復手段が不要分 割線除去手段と再分割手段とを備えた場合には、冗長部 除去手段によって冗長部における図形データの重複除去 10 が行なわれた後に、不要分割線除去手段によって図形処 理領域内の図形データの不要分割線を除去することがで き、再分割手段によって上記の不要分割線が除去された 後の図形データを基本図形に再分割することが可能とな る。図形処理領域全体で上記のような処理を行なうこと により、冗長部境界における微小図形データの発生を効 果的に抑制するととが可能となる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 との発明の実施の形態1における荷電ビーム 描画データ作成装置の概略構成を示すブロック図であ る。

【図2】 図1に示される荷電ビーム描画データ作成装 置を用いた特徴的な処理工程の第1工程を示す図であ

【図3】 図1に示される荷電ビーム描画データ作成装 置を用いた特徴的な処理工程の第2工程を示す図であ

【図4】 (a)と(b)は、図1に示される荷電ビー ム描画データ作成装置を用いた特徴的な処理工程の第3 工程を示す図である。

【図5】 (a)と(b)は、図1に示される荷電ビー ム描画データ作成装置を用いた特徴的な処理工程の第4 工程を示す図である。

【図6】 (a)と(b)は、図1に示される荷電ビー ム描画データ作成装置を用いた特徴的な処理工程の第5 工程を示す図である。

【図7】 図1に示される荷電ビーム描画データ作成装 置を用いた特徴的な処理工程の第6工程を示す図であ る。

(a) は図形処理領域と冗長領域とを示す図 40 【図8】 であり、(b)はこの発明に係る冗長部を斜線で示す図 であり、(c)はこの発明に係る内部領域を斜線で示す 図である。

【図9】 との発明の実施の形態2における荷電ビーム 描画データ作成装置の概略構成を示すブロック図であ る。

【図10】 図9に示される荷電ビーム描画データ作成 装置を用いた特徴的な処理工程の第1工程を示す図であ

【図11】 図9に示される荷電ビーム描画データ作成 50 【図31】 冗長部除去処理を示すフローチャートであ

装置を用いた特徴的な処理工程の第2工程を示す図であ

【図12】 (a)と(b)は、図9に示される荷電ビ ーム描画データ作成装置を用いた特徴的な処理工程の第 3工程を示す図である。

【図13】 (a)と(b)は、図9に示される荷電ビ ーム描画データ作成装置を用いた特徴的な処理工程の第 4工程を示す図である。

【図14】 (a)と(b)は、図9に示される荷電ビ ーム描画データ作成装置を用いた特徴的な処理工程の第 5工程を示す図である。

【図15】 図9に示される荷電ビーム描画データ作成 装置を用いた特徴的な処理工程の第6工程を示す図であ る。

【図16】 との発明に係る図形修復手段の構成の一例 を示すプロック図である。

【図17】 図16に示される図形修復手段を用いた図 形修復処理を説明するためのフローチャートである。

【図18】 図形修復手段の構成の他の例を示すブロッ 20 ク図である。

【図19】 図18に示される図形修復手段を用いた図 形修復処理を示すフローチャートである。

【図20】 パターンデータの一例を示す図である。

【図21】 図20に示されるパターンデータを水平方 向の分割線で分割した場合を示す図である。

【図22】 図20に示されるパターンデータを垂直方 向の分割線で分割した場合を示す図である。

【図23】 図20に示されるパターンデータを用いて マスク上に形成されたレジストパターンの形状を示す図 30 である。

【図24】 1ショットの電子ビームで描画された場合 のマスク上のレジストパターン寸法のばらつきを示す図

【図25】 2ショットの電子ビームで描画された場合 のマスク上のレジストバターン寸法のばらつきを示す図 である。

【図26】 1ショットの電子ビームで描画された場合 の描画図形(a)と電子ビームの強度分布(b)を示す 図である。

【図27】 2ショットの電子ピームで描画された場合 の描画図形(a)と電子ビームの強度分布(b)を示す 図である。

【図28】 微小サイズの電子ビームを含む2ショット ・の電子ビームで描画された場合のマスク上のレジストパ ターン寸法のばらつきを示す図である。

【図29】 従来の荷電ビーム描画データ作成装置の概 略構成を示すブロック図である。

[図30] (a)と(b)は、図形間の重複除去処理 (スラブ法)を説明するための図である。

